

Протокол научного семинара по теме «Элементная база СБИС: транзисторные структуры»	4
Презентации, предоставленные авторами для публикации	15
К.ф.-м.н. В.В. Вьюрков, член-корреспондент РАН В.Ф. Лукичев, д.ф.-м.н. К.В. Руденко (ФТИАН им. К.А. Валиева РАН). Перспективные транзисторы для КМОП УБИС с суб-10 нм критическими размерами. Член-корреспондент РАН А.А. Горбацевич (ФИАН, НИУ «МИЭТ»), академик РАН Г.Я. Красников (АО «НИИМЭ»), Н.М. Шубин (ФИАН, НИУ «МИЭТ»). Квантовые интерференционные транзисторы со сверхнизким энергопотреблением.....	15
Д.ф.-м.н. А.А. Шашкин (ИФТТ РАН). Сравнение сценариев перехода металл-диэлектрик в МОП-структурах кремния и кремний-германиевых квантовых ямах рекордной подвижности.....	36
Д.т.н. К.О. Петросянц (НИУ ВШЭ, ИППМ РАН), Д.А. Попов (НИУ ВШЭ). Оценка радиационной и температурной стойкости субмикронных МОП КНИ транзисторных структур с различной конфигурацией скрытого оксида.	54
К.т.н. А.Р. Сафин (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), член-корреспондент РАН С.А. Никитов (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, МФТИ). Генерация СВЧ и терагерцового излучения спинтронными структурами.....	69
Д.ф.-м.н. Е.Д. Мишина, к.ф.-м.н. С.Д. Лавров, академик РАН А.С. Сигов (РТУ МИРЭА). Транзисторы для СБИС на основе двумерных полупроводников.....	83
К.т.н. Ю.А. Степченков (ИПИ РАН ФИЦ ИУ РАН) Самосинхронная схемотехника на базе двухполярного источника питания и новых транзисторных структур.....	101
	116